

InGaAs фотодиод 1654 нм, 500 мкм, ТО-корпус — техническое описание

P/N: WIT3-500C1

ОСОБЕННОСТИ

Высокая чувствительность
Низкий темновой ток; спектральная чувствительность 900–1740 нм

ПРИМЕНЕНИЕ

Детектирование в ближнем ИК-диапазоне, газовые сенсоры; мониторинг; измерительные приборы

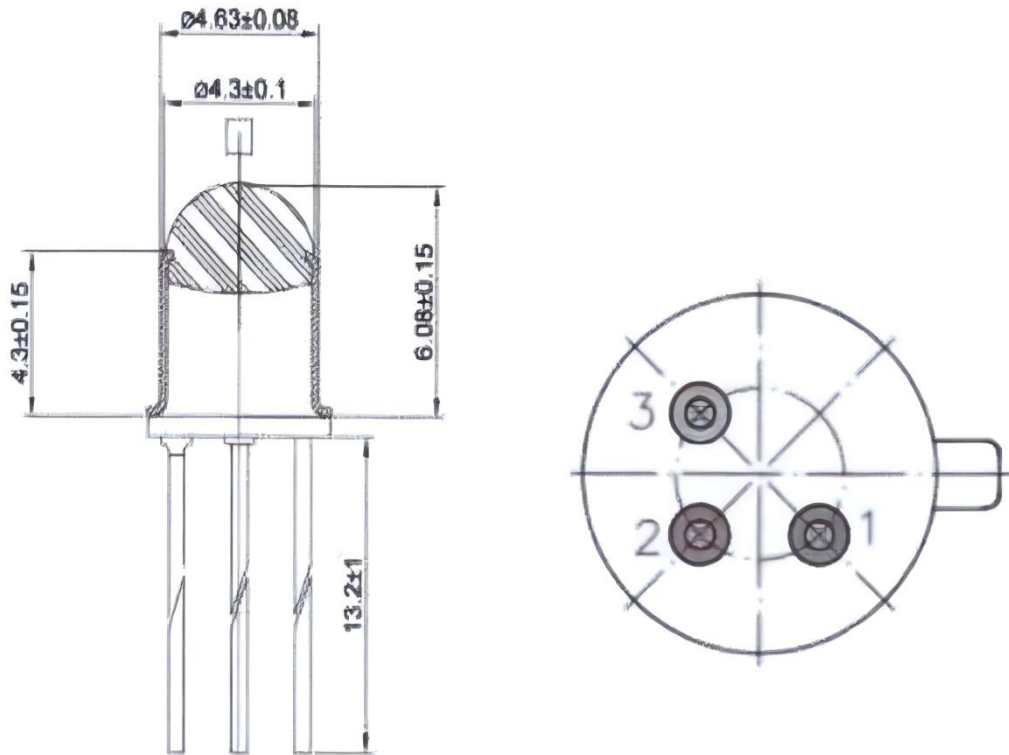
Электрооптические характеристики (T=25 °C, Vcc=3.3 В)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Чувствительность	R	@1654nm,VR=0V	0.9	1.0	-	А/Вт
Темновой ток	Id	VR=-5V	-	0.2	1	нА
Рабочий диапазон длин волн	λ	-	900	1650	1740	нм
Активная область	φ	-	498	500	502	мкм
Емкость	C	VR=-5V	-	15	25	пФ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Обозначение	Мин.	Макс.	Ед. изм.
Рабочая температура	Top	-40	85	°C
Температура хранения	Tstg	-40	125	°C
Прямой ток	IF	-	10	мА

Назначение выводов и габаритный чертёж



Вывод	Номер
1	PD+
2	PD-
3	GND